

Célula Solar

Energía Solar Fotovoltaica

Oscar Perpiñán Lamigueiro

<http://oscarperpinan.github.io>

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

Teoría de Semiconductores

Conducción eléctrica

Semiconductores

Dopaje de semiconductores

Unión p-n

Diodo

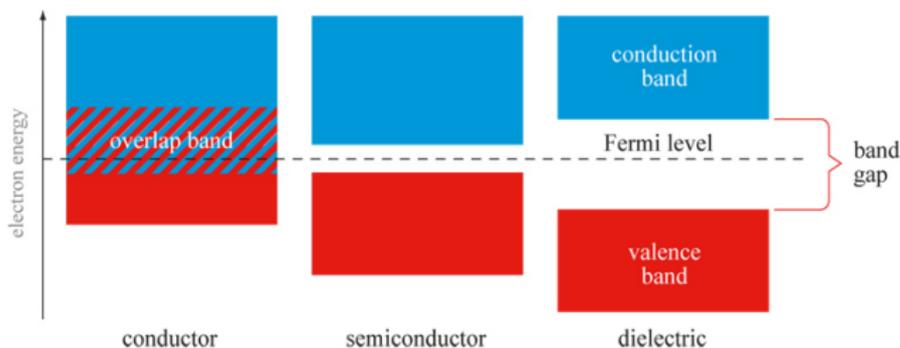
Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

Bandas de energía

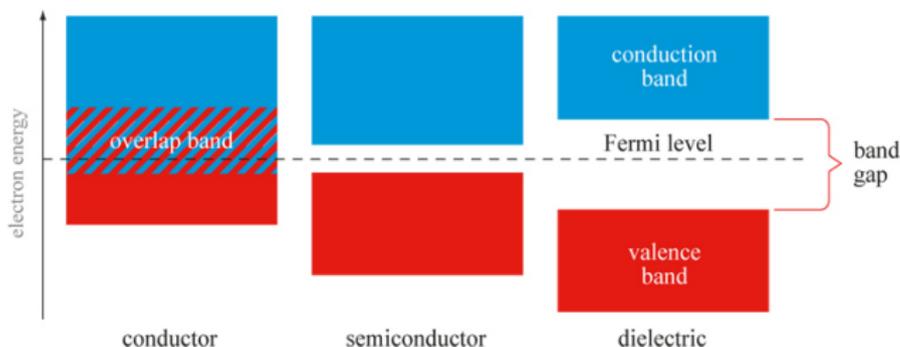
- ▶ En un **sólido** el número de átomos es tan elevado que los niveles de energía forman **bandas continuas de energía**.
- ▶ Los **electrones** asociados a los átomos del sólido **llenan estas bandas en orden ascendente**.



[†]<http://commons.wikimedia.org/>

Bandas de energía

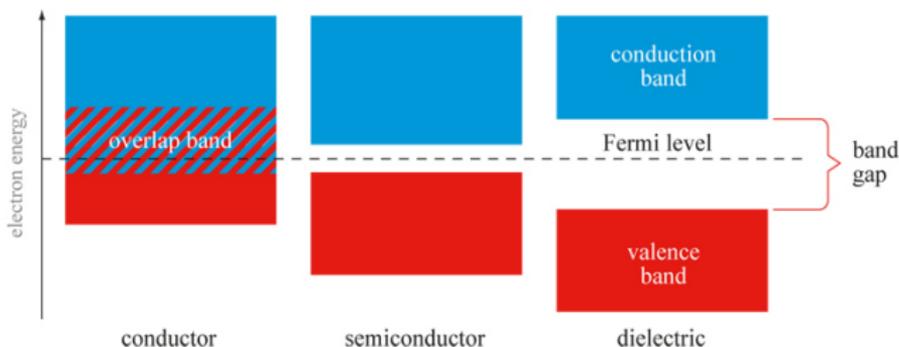
- ▶ La banda de mayor energía completamente ocupada se denomina **banda de valencia** (*electrones ligados a átomos*).
- ▶ La siguiente banda, parcialmente ocupada o vacía, se denominada **banda de conducción** (*electrones desligados de átomos*).



[†]<http://commons.wikimedia.org/>

Bandas de energía

- ▶ Estas bandas pueden estar separadas por otra banda de energías que corresponde a **estados no permitidos (banda prohibida)**, o **pueden estar solapadas** permitiendo una transición fácil de una a otra.

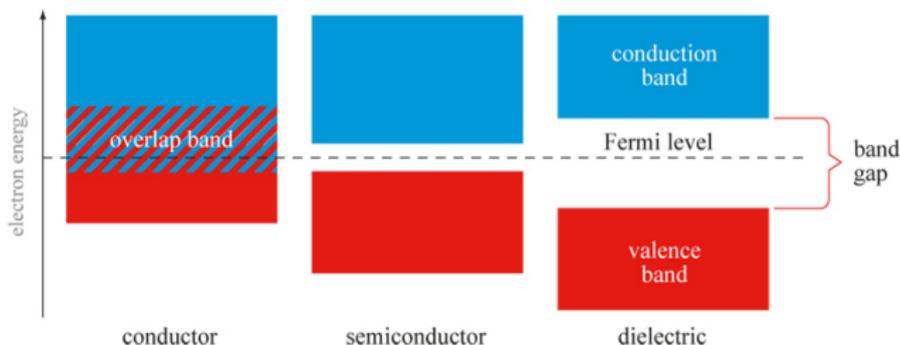


[†]<http://commons.wikimedia.org/>

Conductores, aislantes y semiconductores

Las **propiedades eléctricas** del sólido dependen de esta **posición relativa entre bandas**.

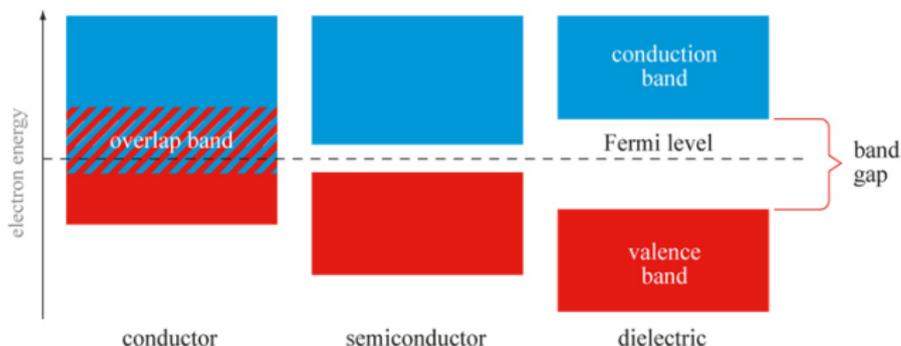
- ▶ En un **conductor** la E_g es muy baja y los electrones circulan fácilmente por la banda de conducción.



Conductores, aislantes y semiconductores

Las **propiedades eléctricas** del sólido dependen de esta **posición relativa entre bandas**.

- ▶ En un **aislante** se necesita una cantidad de energía muy alta para que los electrones puedan acceder a la banda de conducción ($E_g > 5 \text{ eV}$)

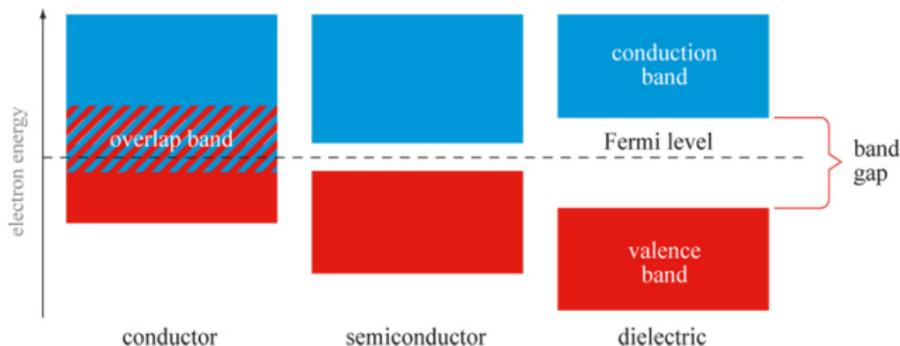


Conductores, aislantes y semiconductores

Las **propiedades eléctricas** del sólido dependen de esta **posición relativa entre bandas**.

- ▶ En un **semiconductor** la E_g es baja ($E_g < 5 \text{ eV}$): los electrones pueden «saltar» a la banda de conducción con un aporte energético.

- ▶ $E_g(\text{Si}) = 1,12 \text{ eV}$
- ▶ $E_g(\text{AsGa}) = 1,4 \text{ eV}$



Teoría de Semiconductores

Conducción eléctrica

Semiconductores

Dopaje de semiconductores

Unión p-n

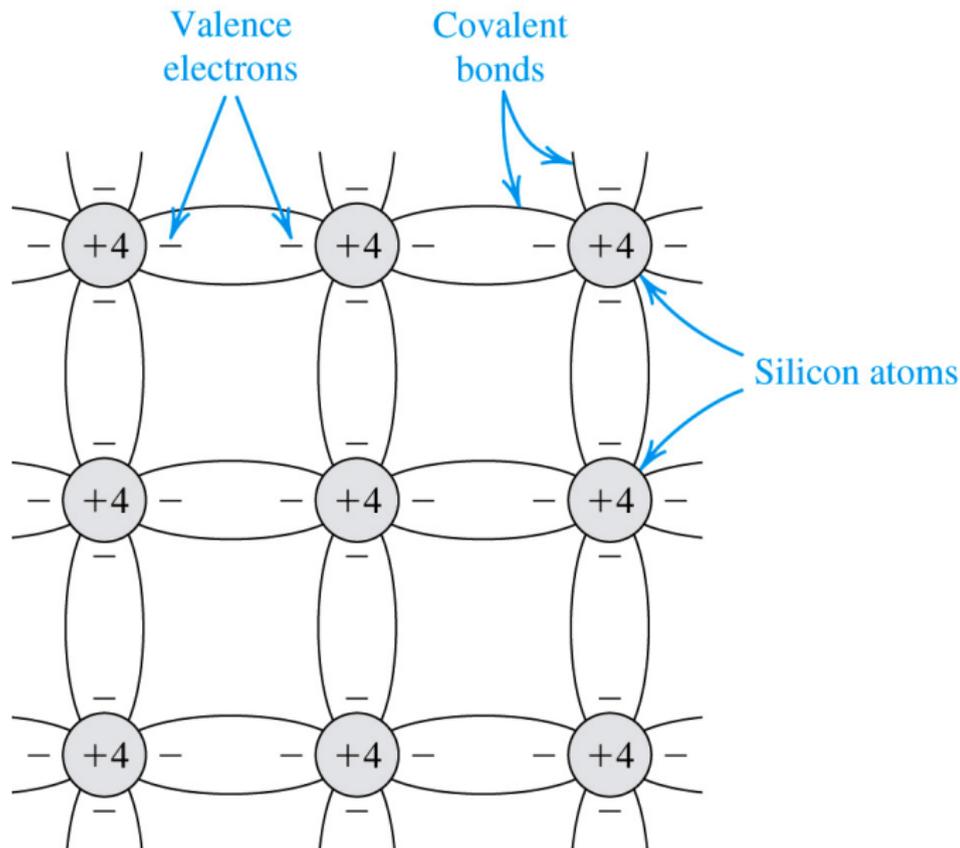
Diodo

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

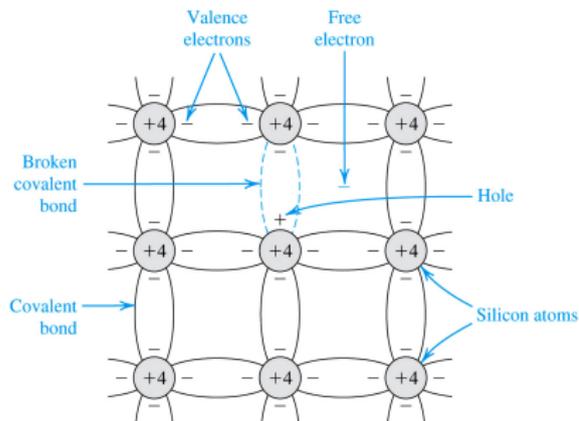
Red cristalina de Si ($T = 0\text{ K}$)



[†]Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

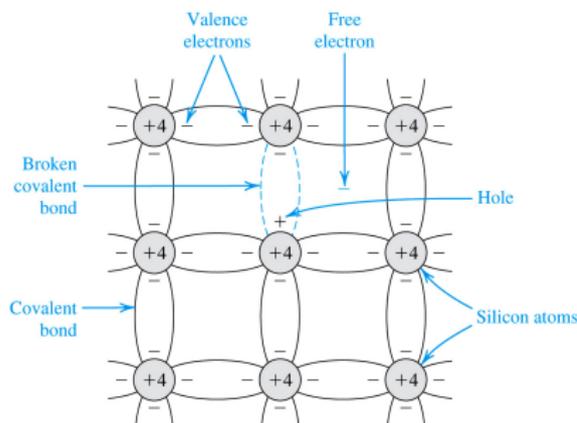
Generación de electrón-hueco ($T > 0\text{ K}$)

- ▶ Cuando se **rompe un enlace**, un electrón y un hueco quedan libres para moverse por el material (conducción intrínseca).



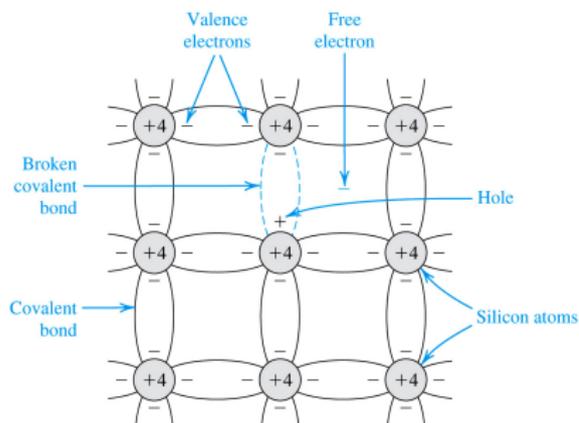
Generación de electrón-hueco ($T > 0\text{ K}$)

- ▶ Cuando se **rompe un enlace**, un electrón y un hueco quedan libres para moverse por el material (conducción intrínseca).
- ▶ Esta **circulación es aleatoria**, sin una dirección predeterminada: **no es aprovechable** en un circuito externo.



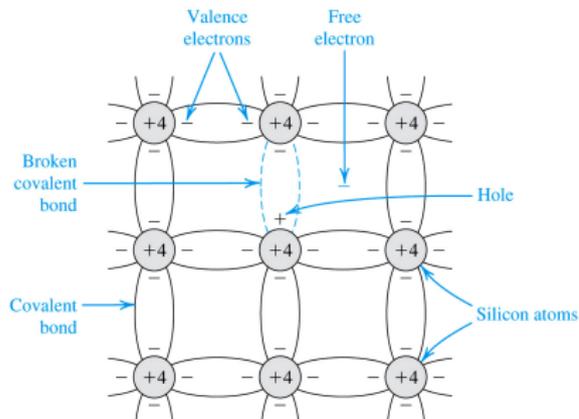
Generación de electrón-hueco ($T > 0\text{ K}$)

- ▶ Cuando se **rompe un enlace**, un electrón y un hueco quedan libres para moverse por el material (conducción intrínseca).
- ▶ Esta **circulación es aleatoria**, sin una dirección predeterminada: **no es aprovechable** en un circuito externo.
- ▶ La **densidad intrínseca de huecos y electrones es idéntica** (depende de la temperatura y de E_g).



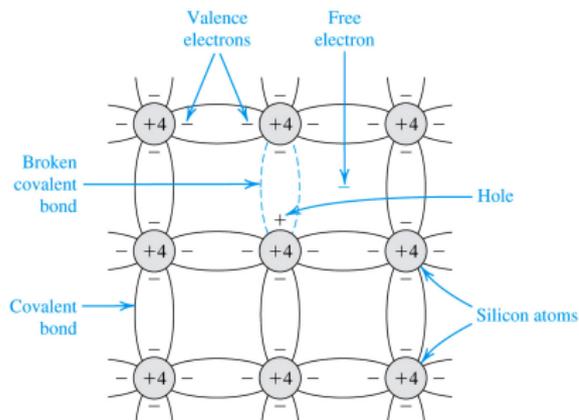
Recombinación de un par electrón-hueco

- Se producen **encuentros electrón-hueco** que restablecen un enlace con **liberación de energía** (E_g) en forma de calor.



Recombinación de un par electrón-hueco

- ▶ Se producen **encuentros electrón-hueco** que restablecen un enlace con **liberación de energía** (E_g) en forma de calor.
- ▶ Para evitar la recombinación es **preciso dirigir el movimiento** de electrones y huecos mediante un campo eléctrico.



Teoría de Semiconductores

Conducción eléctrica

Semiconductores

Dopaje de semiconductores

Unión p-n

Diodo

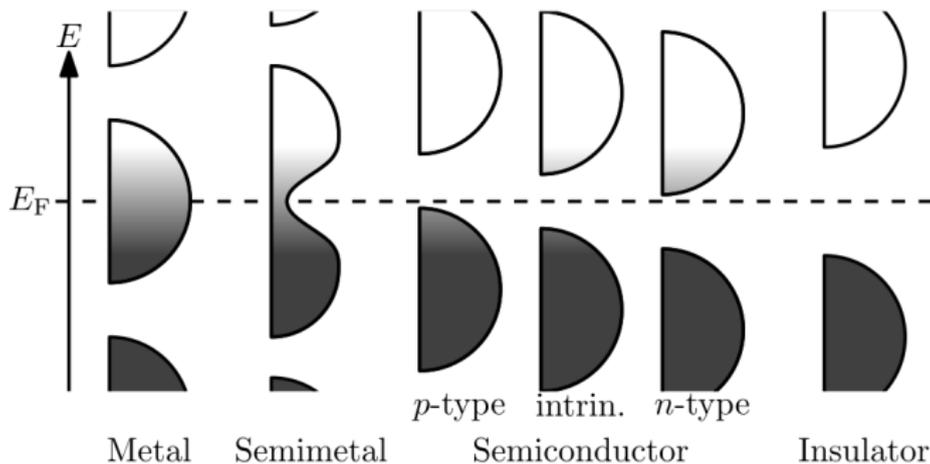
Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

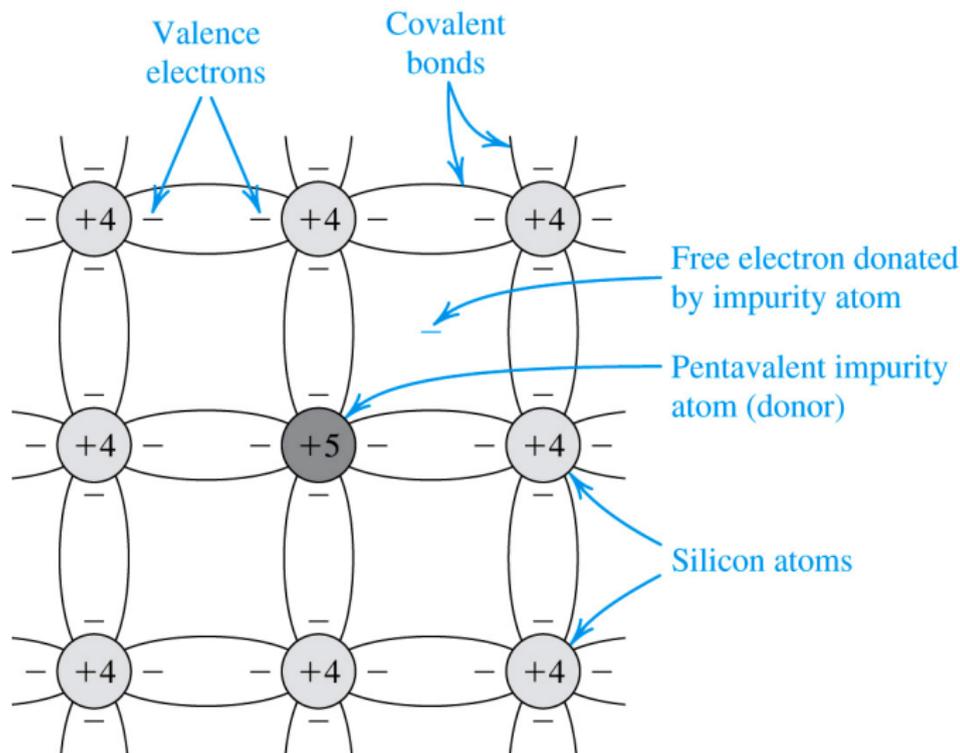
Fabricación

Definición

El **dopaje de semiconductores** consiste en introducir de forma controlada impurezas en el cristal para alterar las bandas de energía.



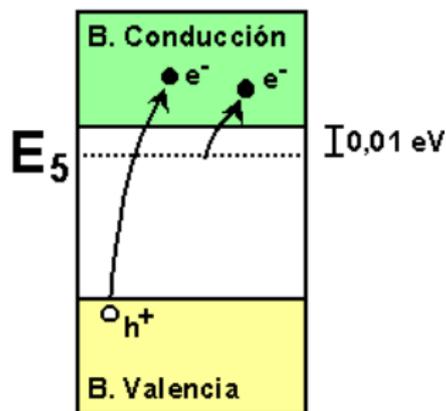
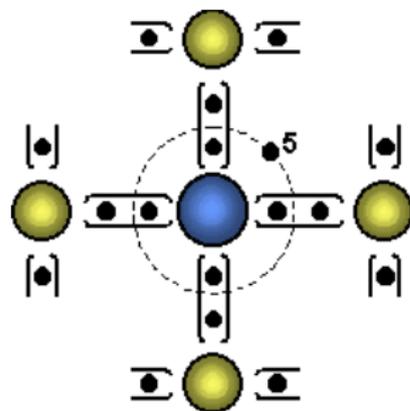
Tipo n



[†]Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

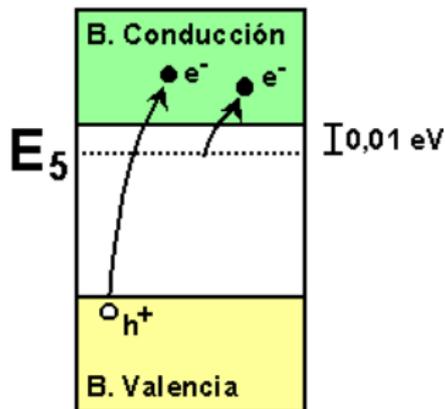
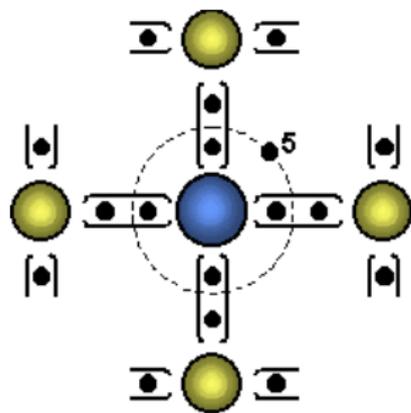
Tipo n

- ▶ Los átomos de **Fósforo** tienen cinco electrones de valencia (uno más que el silicio).



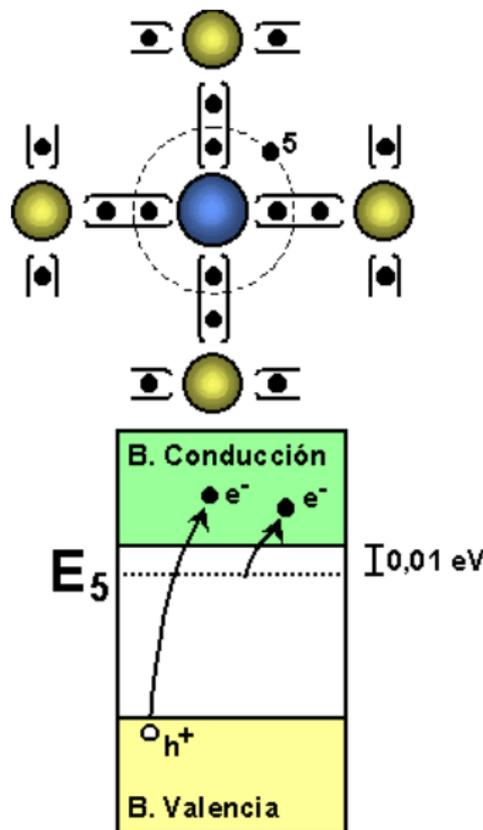
Tipo n

- ▶ Los átomos de **Fósforo** tienen cinco electrones de valencia (uno más que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Fósforo, el quinto electrón no queda bien integrado en la red.



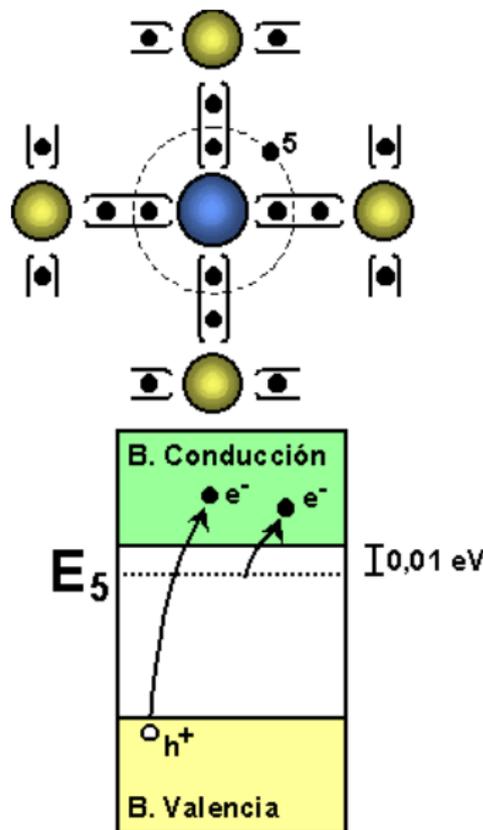
Tipo n

- ▶ Los átomos de **Fósforo** tienen cinco electrones de valencia (uno más que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Fósforo, el quinto electrón no queda bien integrado en la red.
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).



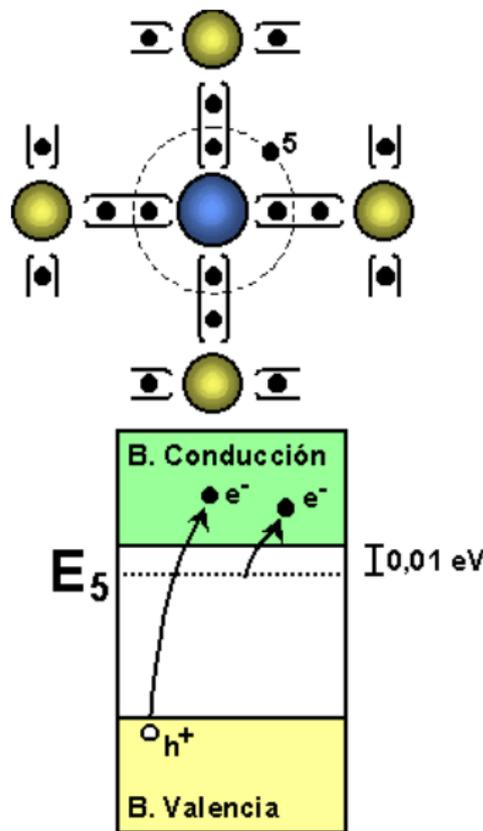
Tipo n

- ▶ Los átomos de **Fósforo** tienen cinco electrones de valencia (uno más que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Fósforo, el quinto electrón no queda bien integrado en la red.
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).
- ▶ El **quinto electrón queda libre** pero la carga positiva (ión P^+) está **ligada** a la red cristalina.

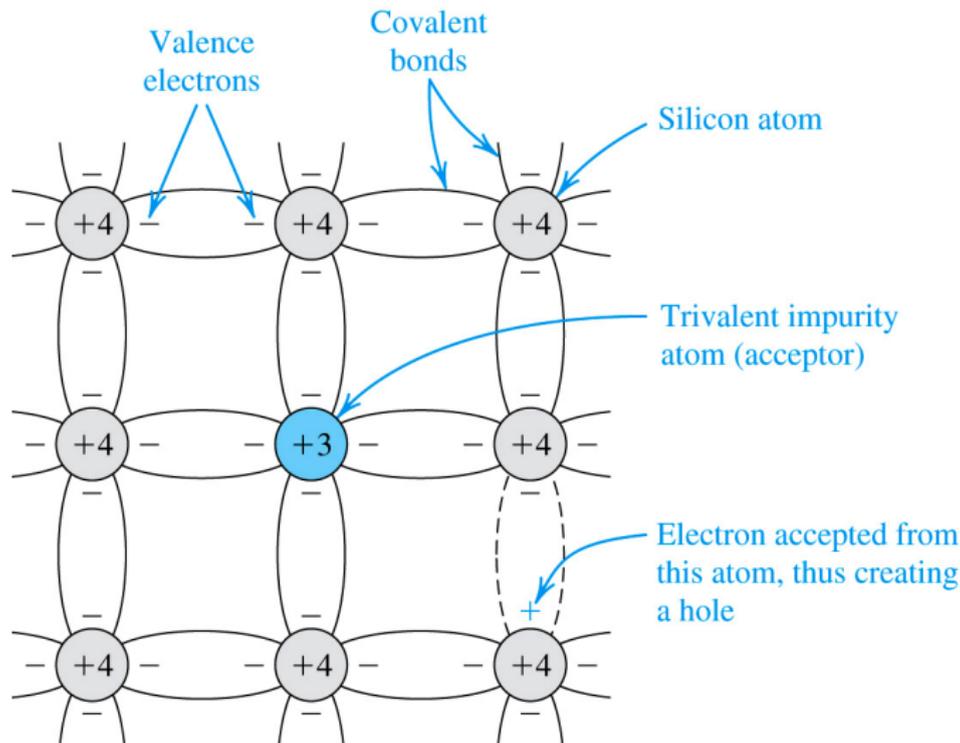


Tipo n

- ▶ Los átomos de **Fósforo** tienen cinco electrones de valencia (uno más que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Fósforo, el quinto electrón no queda bien integrado en la red.
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).
- ▶ El **quinto electrón queda libre** pero la carga positiva (ión P^+) está **ligada** a la red cristalina.
- ▶ La **densidad de electrones** (portador mayoritario) es **superior a la de huecos**



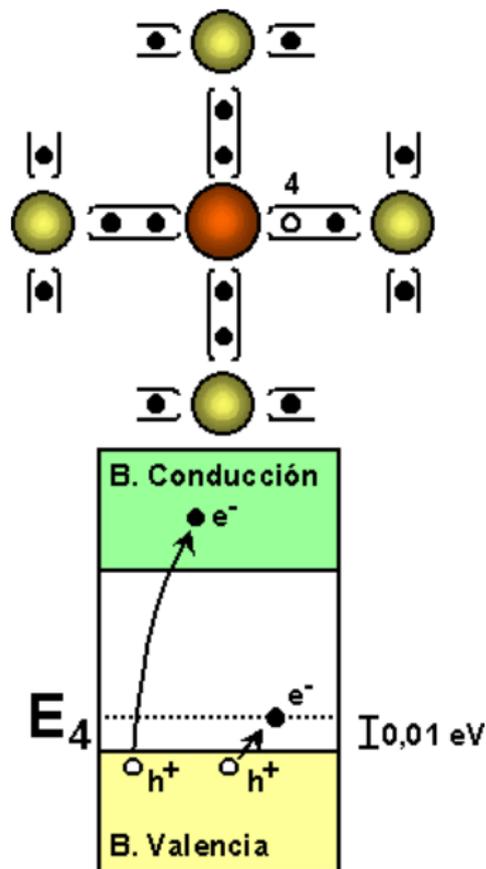
Tipo p



[†]Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

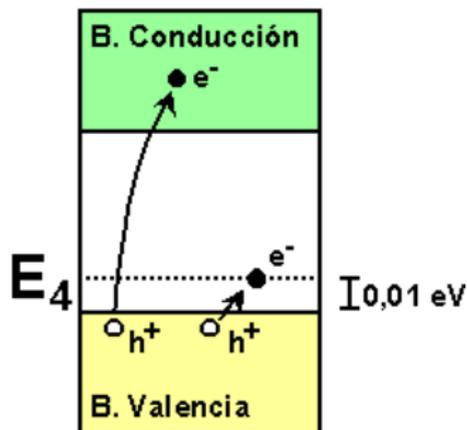
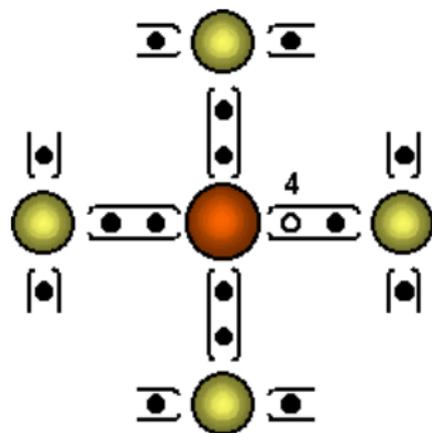
Tipo p

- ▶ Los átomos de **Boro** tienen tres electrones de valencia (uno menos que el silicio).



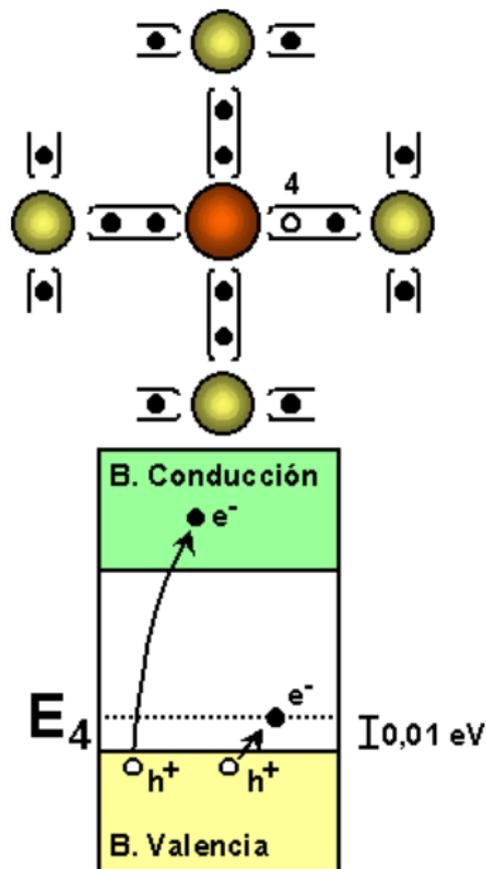
Tipo p

- ▶ Los átomos de **Boro** tienen tres electrones de valencia (uno menos que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Boro, hay un enlace sin cubrir (hueco).



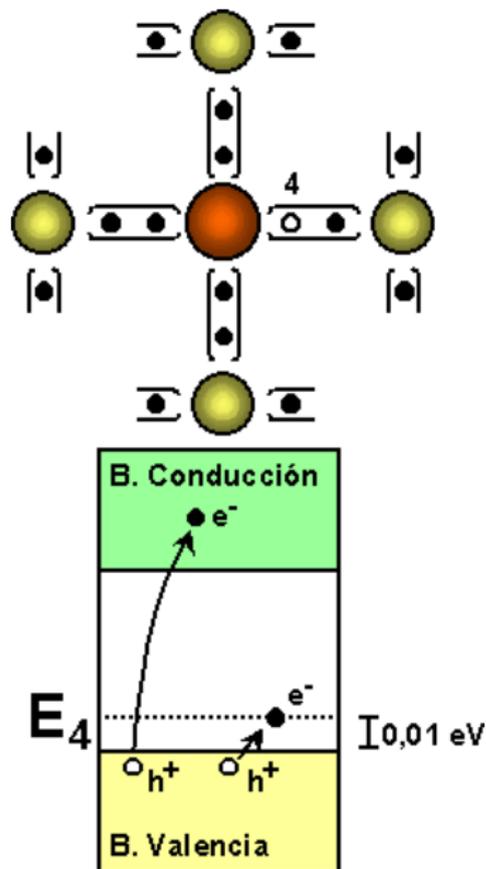
Tipo p

- ▶ Los átomos de **Boro** tienen tres electrones de valencia (uno menos que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Boro, hay un enlace sin cubrir (hueco).
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).



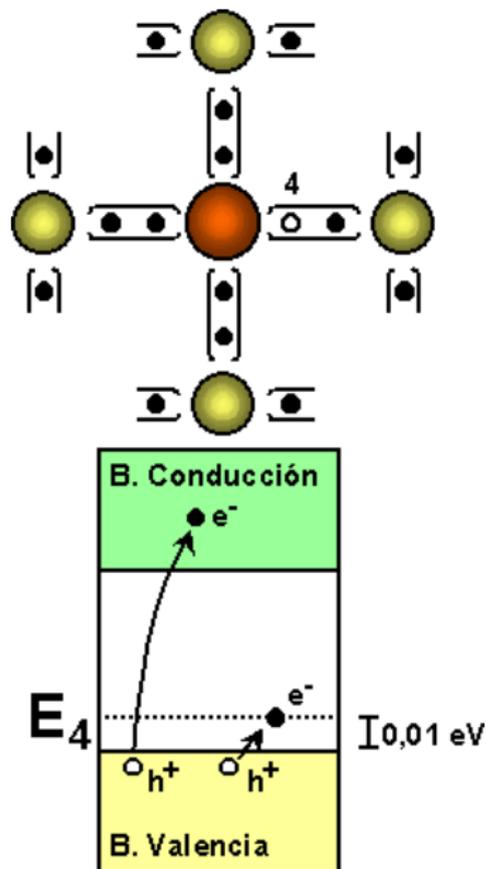
Tipo p

- ▶ Los átomos de **Boro** tienen tres electrones de valencia (uno menos que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Boro, hay un enlace sin cubrir (hueco).
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).
- ▶ El **hueco queda libre** pero la **carga negativa (ión B^-) está ligada** a la red cristalina.



Tipo p

- ▶ Los átomos de **Boro** tienen tres electrones de valencia (uno menos que el silicio).
- ▶ Al impurificar un cristal de Silicio con átomos de Boro, hay un enlace sin cubrir (hueco).
- ▶ La rotura de este enlace se produce con **baja aportación energética** (menor que E_g).
- ▶ El **hueco queda libre** pero la **carga negativa (ión B^-)** está ligada a la red cristalina.
- ▶ La **densidad de huecos** (portador mayoritario) es **superior a la de electrones**



Teoría de Semiconductores

Conducción eléctrica

Semiconductores

Dopaje de semiconductores

Unión p-n

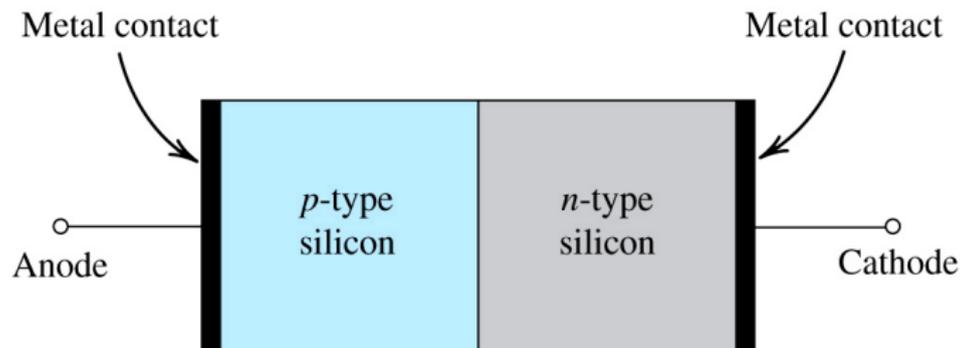
Diodo

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

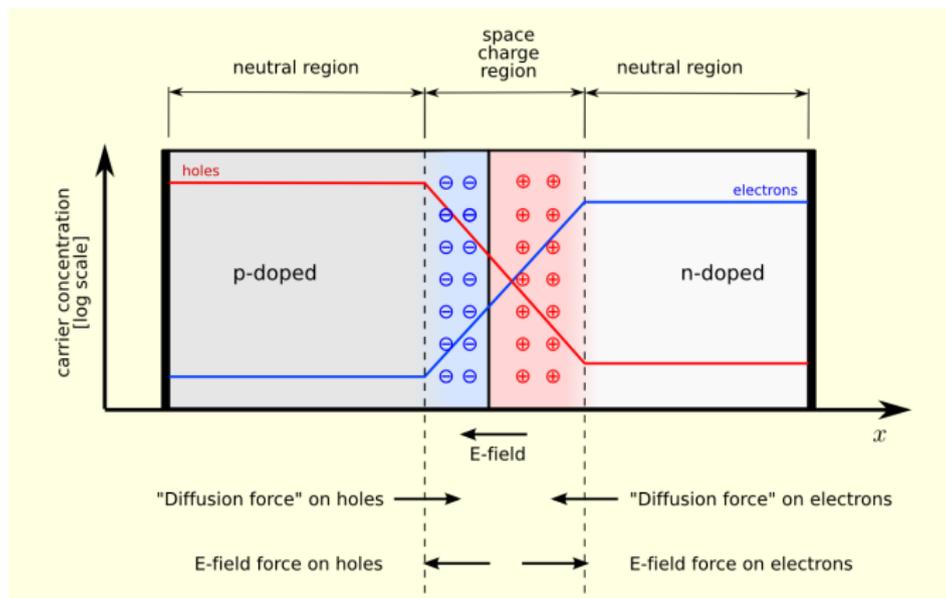
Unión p-n



[†]Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

Conducción en una unión p-n

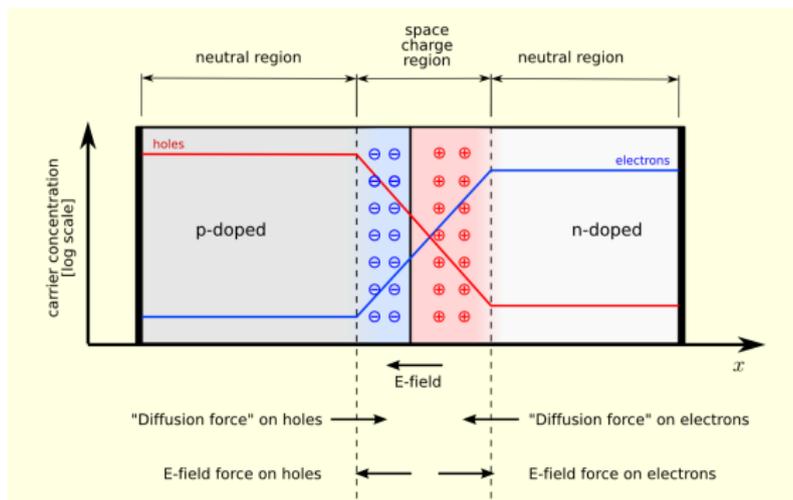
- ▶ Al unir un semiconductor tipo p con otro tipo n, se produce un desequilibrio:
 - ▶ Corriente de Difusión
 - ▶ Corriente de Arrastre



†Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

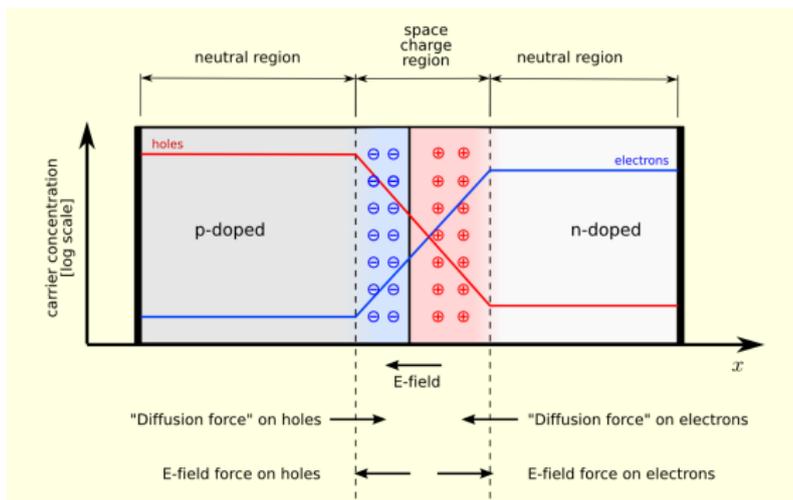
► Difusión de portadores mayoritarios

- Movimiento de huecos desde cristal p a cristal n, dejando iones con carga negativa.



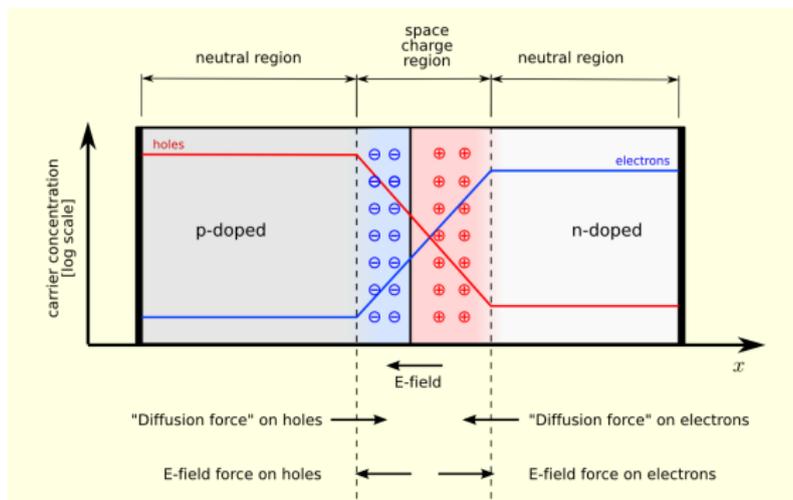
► Difusión de portadores mayoritarios

- Movimiento de huecos desde cristal p a cristal n, dejando iones con carga negativa.
- Movimiento de electrones desde cristal n a cristal p, dejando iones con carga positiva.



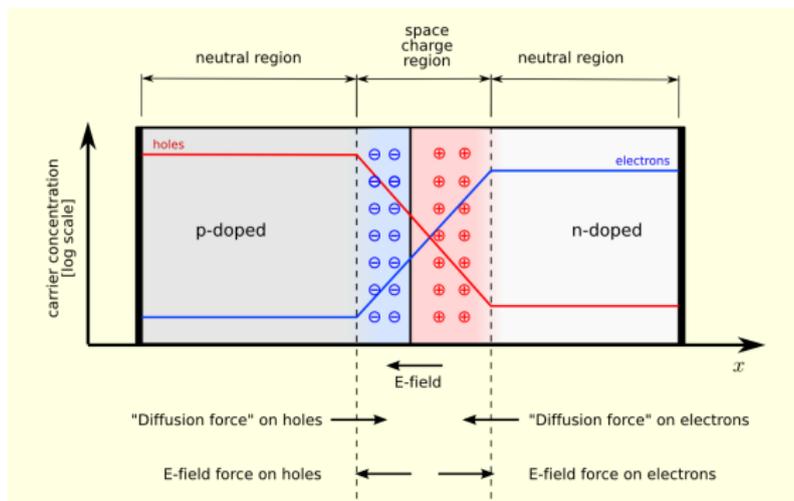
Corriente de Arrastre

- ▶ **Los iones fijos** cercanos a la unión generan un **campo eléctrico de arrastre** en sentido opuesto a la difusión: **barrera de potencial**



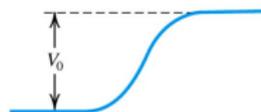
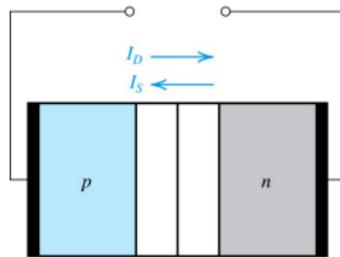
Corriente de Arrastre

- ▶ Los **iones fijos** cercanos a la unión generan un **campo eléctrico de arrastre** en sentido opuesto a la difusión: **barrera de potencial**
- ▶ Los **portadores minoritarios** que atraviesan la **unión se recombinan** en la **zona cercana a la unión** despoblada de portadores y con iones cargados ligados a la red.



Equilibrio en una unión p-n

- ▶ El **equilibrio** se alcanza al **compensarse los movimientos de difusión y de arrastre**.

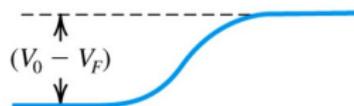
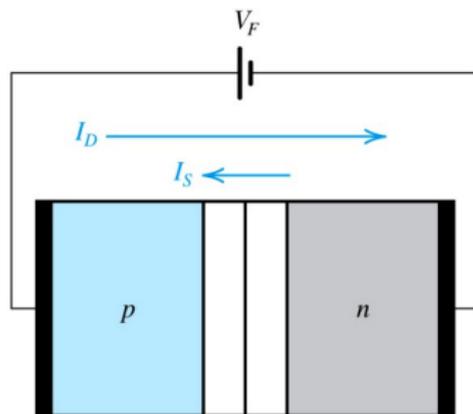


(a) Open-circuit
(Equilibrium)

[†]Figura de Sedra and Smith, Microelectronic Circuits

Polarización en directa

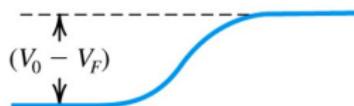
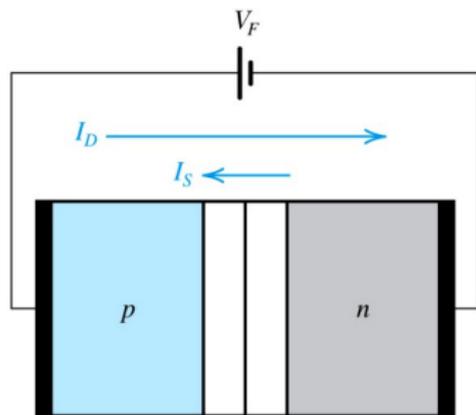
- Para **conseguir corriente** es necesario **romper el equilibrio** alcanzado y **reducir la barrera de potencial**.



(c) Forward Bias

Polarización en directa

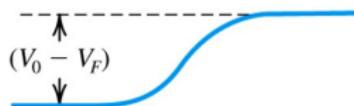
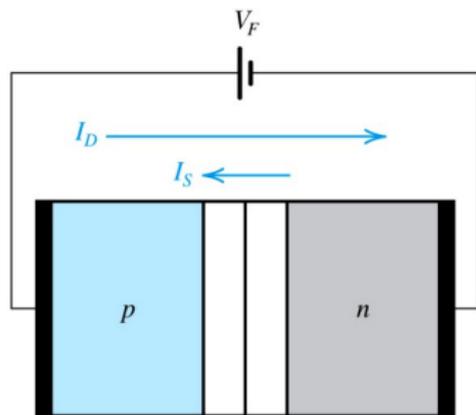
- ▶ Para **conseguir corriente** es necesario **romper el equilibrio** alcanzado y **reducir la barrera de potencial**.
- ▶ Diferencia de potencial con lado **p** **positivo respecto al lado n**: unión p-n está polarizada en directa.



(c) Forward Bias

Polarización en directa

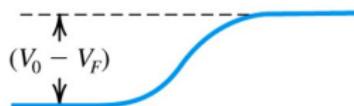
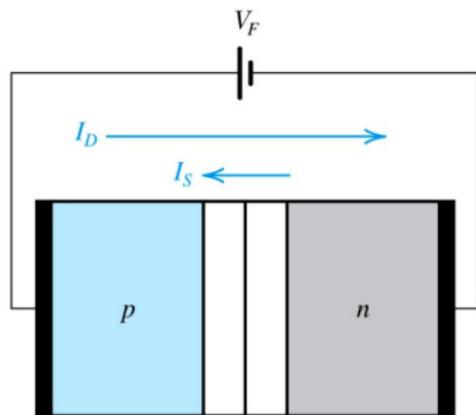
- ▶ Para **conseguir corriente** es necesario **romper el equilibrio** alcanzado y **reducir la barrera de potencial**.
- ▶ Diferencia de potencial con lado **p positivo respecto al lado n**: unión p-n está polarizada en directa.
- ▶ En estas condiciones **se reduce la barrera de potencial** y, en consecuencia el valor del campo eléctrico de la zona de unión.



(c) Forward Bias

Polarización en directa

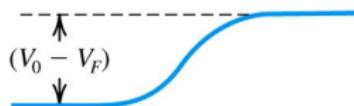
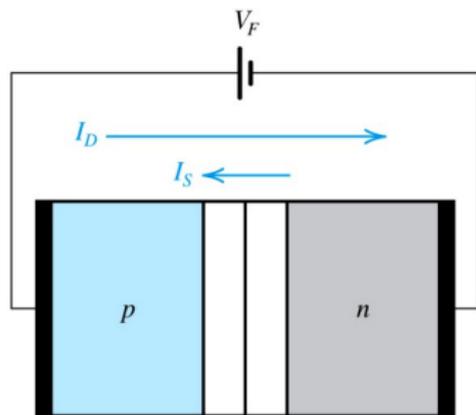
- ▶ Para **conseguir corriente** es necesario **romper el equilibrio** alcanzado y **reducir la barrera de potencial**.
- ▶ Diferencia de potencial con lado **p positivo respecto al lado n**: unión p-n está polarizada en directa.
- ▶ En estas condiciones **se reduce la barrera de potencial** y, en consecuencia el valor del campo eléctrico de la zona de unión.
- ▶ La **corriente de arrastre disminuye** y **no puede compensar la corriente de difusión**.



(c) Forward Bias

Polarización en directa

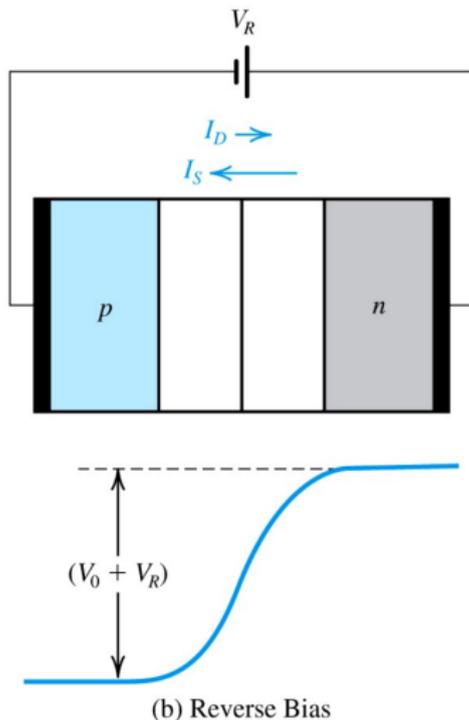
- ▶ Para **conseguir corriente** es necesario **romper el equilibrio** alcanzado y **reducir la barrera de potencial**.
- ▶ Diferencia de potencial con lado **p positivo respecto al lado n**: unión p-n está polarizada en directa.
- ▶ En estas condiciones **se reduce la barrera de potencial** y, en consecuencia el valor del campo eléctrico de la zona de unión.
- ▶ La **corriente de arrastre disminuye** y **no puede compensar la corriente de difusión**.
- ▶ Convenio: la corriente entra por zona p y sale por zona n.



(c) Forward Bias

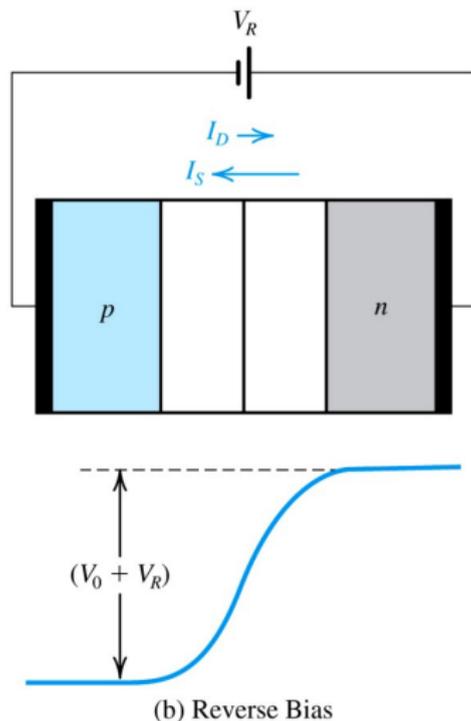
Polarización en inversa

- ▶ Si la diferencia de potencial aplicada consigue que la **zona p** esté a menor tensión que la **zona n**, la unión queda polarizada en inversa.



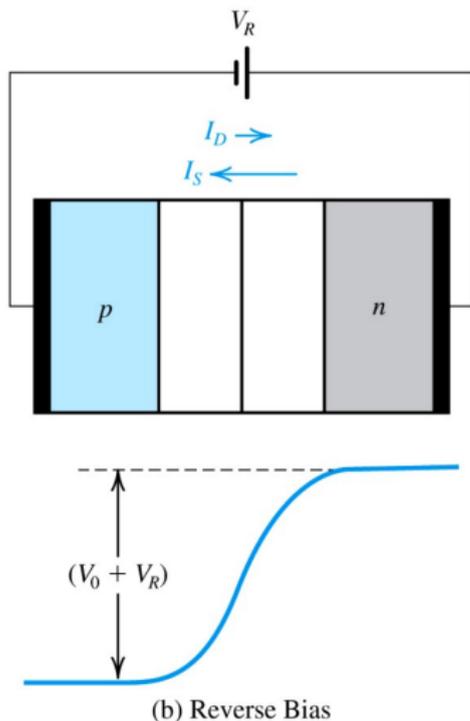
Polarización en inversa

- ▶ Si la diferencia de potencial aplicada consigue que la **zona p** esté a **menor tensión que la zona n**, la unión queda polarizada en inversa.
- ▶ En estas condiciones **la barrera de potencial en la unión queda reforzada** y el paso de portadores de una a otra zona queda aún más debilitado.



Polarización en inversa

- ▶ Si la diferencia de potencial aplicada consigue que la **zona p** esté a **menor tensión que la zona n**, la unión queda polarizada en inversa.
- ▶ En estas condiciones **la barrera de potencial en la unión queda reforzada** y el paso de portadores de una a otra zona queda aún más debilitado.
- ▶ La **corriente que atraviesa la unión en polarización inversa es de muy bajo valor.**



Teoría de Semiconductores

Conducción eléctrica

Semiconductores

Dopaje de semiconductores

Unión p-n

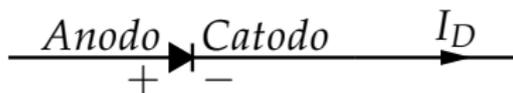
Diodo

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

- ▶ El dispositivo electrónico basado en una unión p-n se denomina diodo.
- ▶ La zona p del diodo es el ánodo y la zona n es el cátodo.



Ecuación del Diodo

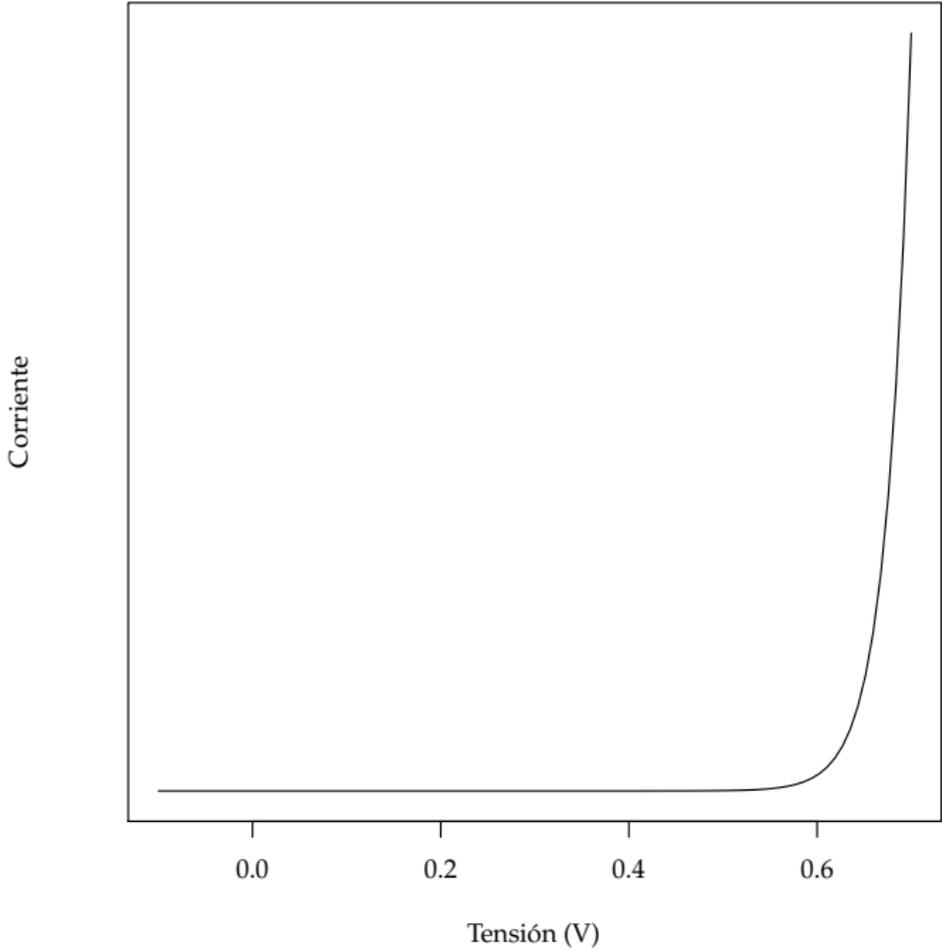
$$I_D = I_0 \cdot \left[\exp\left(\frac{V}{m \cdot V_T}\right) - 1 \right]$$

- ▶ I_0 : corriente de saturación en oscuridad del diodo,
- ▶ V : tensión aplicada al diodo
- ▶ m : factor de idealidad del diodo (1 o 2)

$$V_T = \frac{kT}{e}$$

$$V_T(300 \text{ K}) = 25,85 \text{ mV}$$

- ▶ k : constante de Boltzmann
- ▶ T : temperatura del diodo (en grados Kelvin)
- ▶ e : carga del electrón



Teoría de Semiconductores

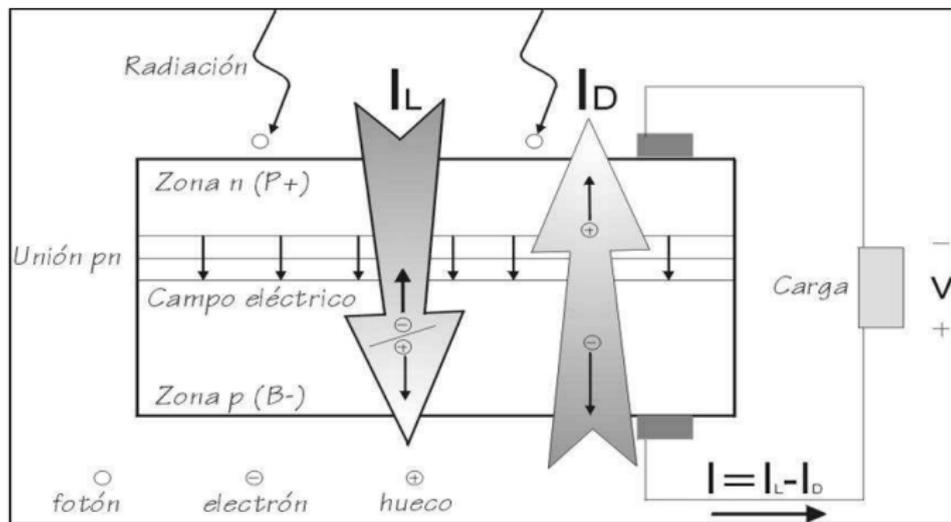
Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

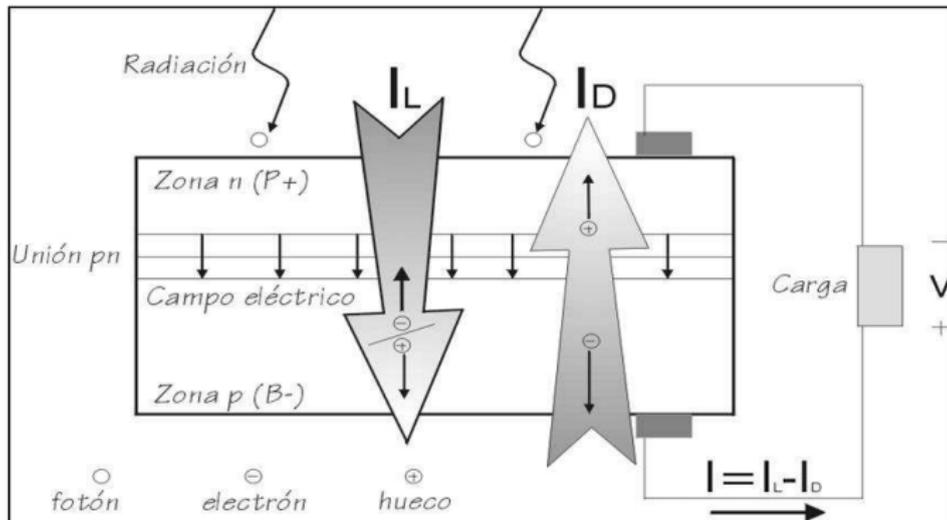
Efecto fotoeléctrico

- ▶ Efecto fotoeléctrico: **los electrones se desplazan a la banda de conducción por el aporte energético de fotones** ($E_f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$).



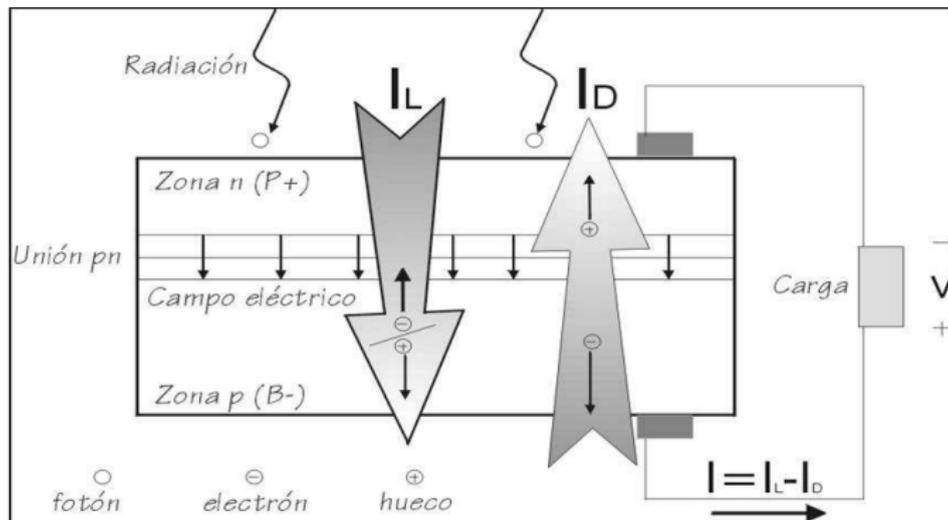
Unión p-n iluminada

- ▶ Al **iluminar una unión p-n**, el **campo eléctrico** de la unión conduce los portadores y **dificulta la recombinación**.



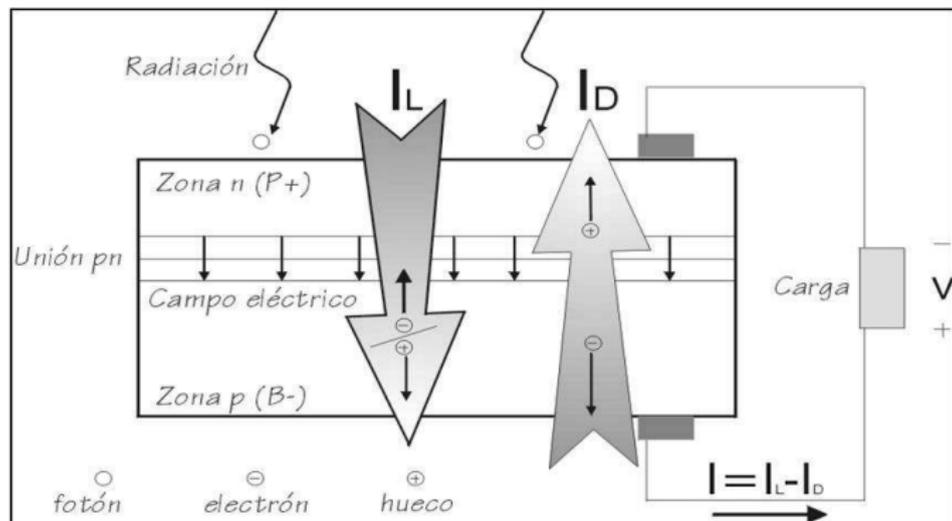
Corriente de Iluminación

- ▶ La **fotocorriente** es ahora **aprovechable** por un circuito externo (*corriente de iluminación, corriente de generación*)



Tensión en Terminales

- ▶ La presencia de **tensión en los terminales** de la unión (por ejemplo, caída de tensión en una resistencia alimentada por la fotocorriente) **favorece la recombinación** (*corriente de oscuridad o corriente de diodo*).



Absorción de luz y generación de portadores

- ▶ Si el fotón es poco energético ($E_f < E_g$) **no interactúa con el semiconductor** (como si fuese transparente)

Absorción de luz y generación de portadores

- ▶ Si el **fotón es poco energético** ($E_f < E_g$) **no interactúa con el semiconductor** (como si fuese transparente)
- ▶ Fotones con $E_f > E_g$:
 - ▶ Los **fotones más energéticos** (baja longitud de onda) son **absorbidos en la superficie** (no rompen enlace)
 - ▶ Los **fotones menos energéticos** (alta longitud de onda) penetran en el interior hasta **romper un enlace**.

Absorción de luz y generación de portadores

- ▶ Si el **fotón es poco energético** ($E_f < E_g$) **no interactúa con el semiconductor** (como si fuese transparente)
- ▶ Fotones con $E_f > E_g$:
 - ▶ Los **fotones más energéticos** (baja longitud de onda) son **absorbidos en la superficie** (no rompen enlace)
 - ▶ Los **fotones menos energéticos** (alta longitud de onda) penetran en el interior hasta **romper un enlace**.
- ▶ Pérdidas:
 - ▶ Diferencia de índices de refracción: **pérdidas de reflexión**
 - ▶ Parte de los portadores generados se recombinan dentro del dispositivo: **pérdidas por recombinación**

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Curva IV y Puntos Característicos

Influencia de Temperatura y Radiación

Cálculo del MPP

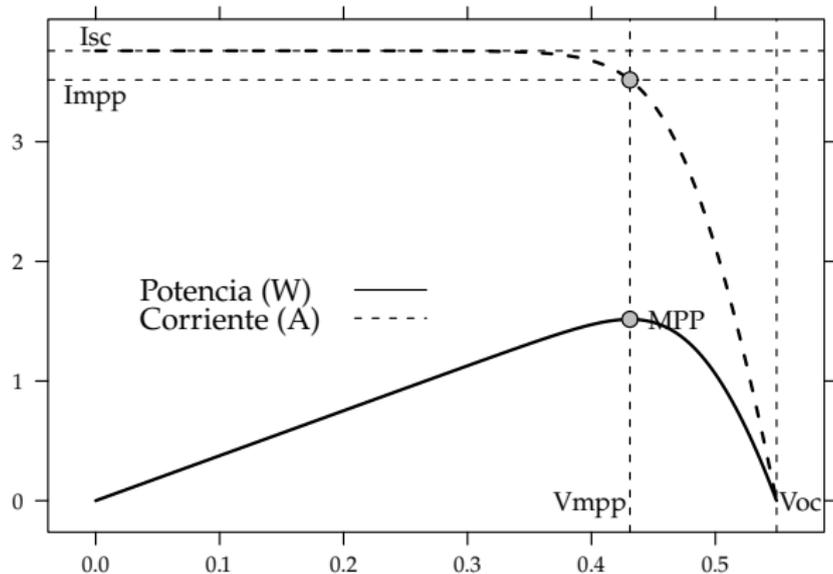
Circuito equivalente de la célula

Fabricación

Característica I-V de iluminación

$$I = I_L - I_D$$

$$I_D = I_0 \cdot \left[\exp \left(\frac{e \cdot V}{m \cdot k \cdot T_c} \right) - 1 \right]$$



Corriente de Cortocircuito

$$I_{sc} = I_L$$

Teoría de
Semiconductores

Unión P-N
iluminada

Funcionamiento
de una célula solar

Curva IV y Puntos
Característicos

Influencia de Temperatura y
Radiación

Cálculo del MPP

Circuito equivalente de la
célula

Fabricación

Tensión de Circuito Abierto

$$V_{oc} = m \cdot \frac{k \cdot T_c}{e} \cdot \ln \left(\frac{I_L}{I_0} + 1 \right)$$

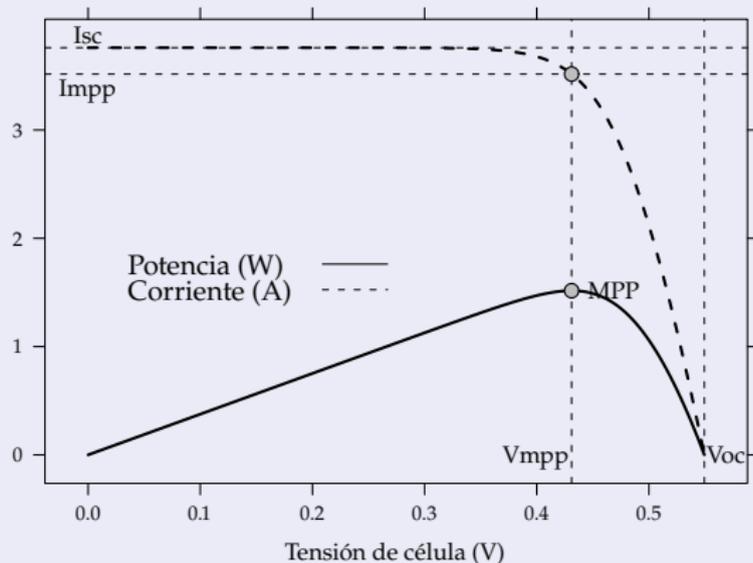
Ecuación general

$$I = I_{sc} \cdot \left[1 - \exp \left(\frac{e \cdot (V_{oc} - V)}{m \cdot k \cdot T_c} \right) \right]$$

Punto de máxima potencia

$$0 < V < V_{mpp}$$

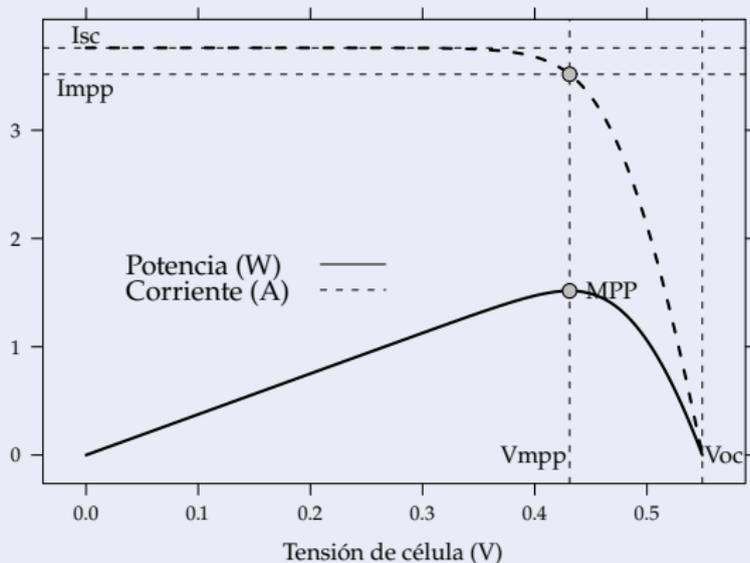
$$\frac{dP}{dV} > 0 \Rightarrow \frac{dI}{dV} > -\frac{I}{V}$$



Punto de máxima potencia

$$V = V_{mpp}$$

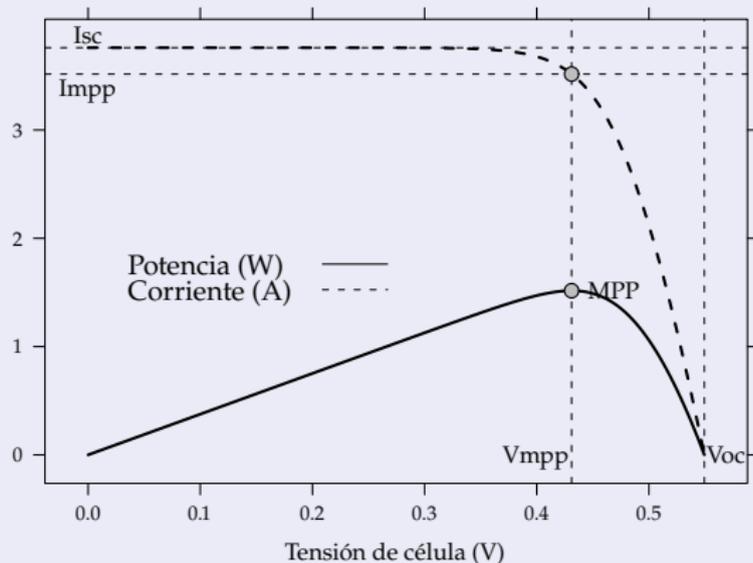
$$\frac{dP}{dV} = 0 \Rightarrow \frac{dI}{dV} = -\frac{I}{V}$$



Punto de máxima potencia

$$V_{mpp} < V < V_{oc}$$

$$\frac{dP}{dV} < 0 \Rightarrow \frac{dI}{dV} < -\frac{I}{V}$$



Factor de forma y Eficiencia

► Factor de Forma

$$FF = \frac{I_{mpp} \cdot V_{mpp}}{I_{sc} \cdot V_{oc}}$$

$$P_{mpp} = FF \cdot I_{sc} \cdot V_{oc}$$

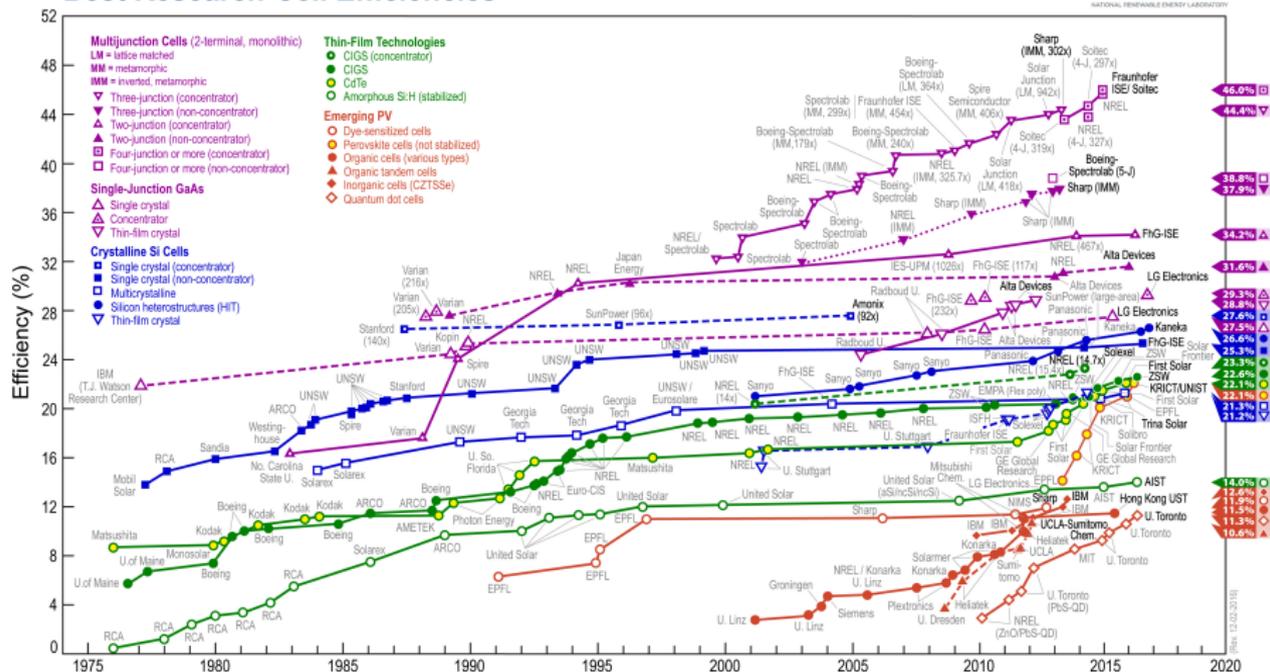
► Eficiencia

$$\eta = \frac{I_{mpp} \cdot V_{mpp}}{P_L}$$

$$\eta = \frac{I_{mpp} \cdot V_{mpp}}{A \cdot G}$$

Eficiencia de células

Best Research-Cell Efficiencies



<http://www.nrel.gov/ncpv/>

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Curva IV y Puntos Característicos

Influencia de Temperatura y Radiación

Cálculo del MPP

Circuito equivalente de la célula

Fabricación

- ▶ **Corriente de cortocircuito proporcional a intensidad de radiación**

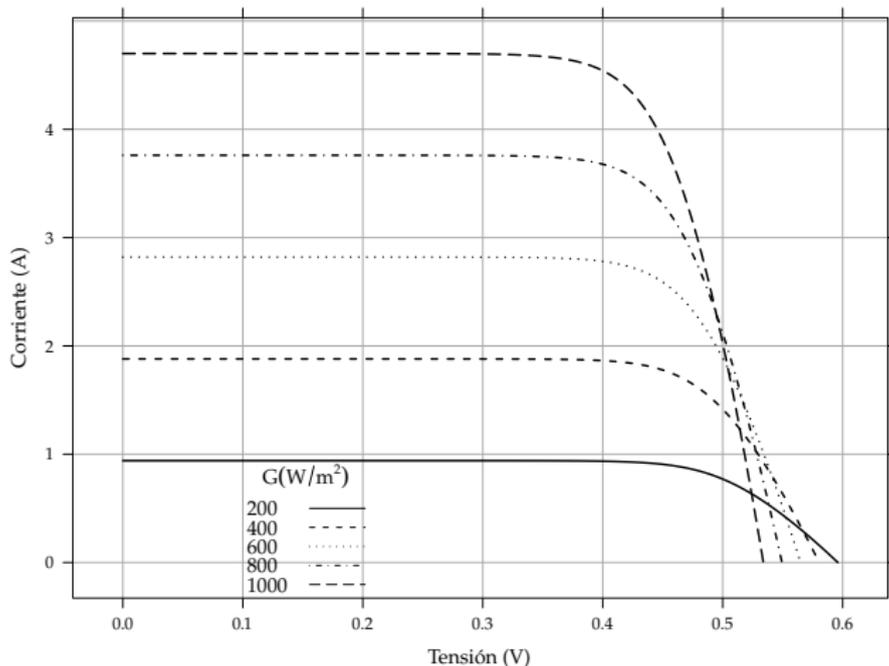
$$I_{sc} = I_{sc}^* \cdot \frac{G_{ef}}{G^*}$$

- ▶ Relación logarítmica con tensión de circuito abierto:

$$V_{oc2} = V_{oc1} + \frac{mkT}{e} \cdot \ln(G_2/G_1)$$

- ▶ El factor de forma aumenta ligeramente
- ▶ La eficiencia crece de forma logarítmica hasta determinado nivel.

Influencia de la Radiación

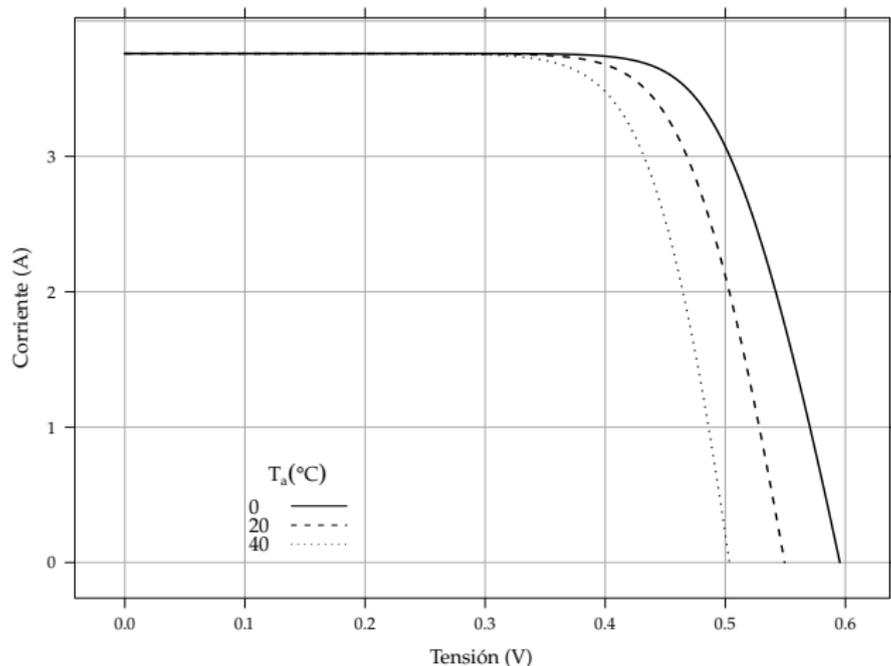


- ▶ Se estrecha el salto entre banda de valencia y conducción: aumenta *ligeramente* la fotocorriente
- ▶ **Disminuye linealmente la tensión de circuito abierto:**

$$dV_{oc}/dT_c = -2,3 \text{ mV } ^\circ\text{C}^{-1}$$

- ▶ Disminuye el factor de forma y la eficiencia:
 $d\eta/dT_c = -0,4 \% ^\circ\text{C}^{-1}$

Influencia de la Temperatura



- ▶ Irradiancia: $G^* = 1000 \text{ W m}^{-2}$ con incidencia normal.
- ▶ Temperatura de célula: $T_c^* = 25 \text{ °C}$.
- ▶ Masa de aire: $AM = 1.5$

$$P_{mpp}^* = I_{mpp}^* \cdot V_{mpp}^*$$

$$\eta^* = \frac{I_{mpp}^* \cdot V_{mpp}^*}{A \cdot G^*}$$

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Curva IV y Puntos Característicos

Influencia de Temperatura y Radiación

Cálculo del MPP

Circuito equivalente de la célula

Fabricación

Método Simplificado: Factor de Forma Constante

Célula Solar

Oscar Perpiñán
Lamigueiro

Teoría de
Semiconductores

Unión P-N
iluminada

Funcionamiento
de una célula solar

Curva IV y Puntos
Característicos

Influencia de Temperatura y
Radiación

Cálculo del MPP

Circuito equivalente de la
célula

Fabricación

$$FF = FF^*$$

$$\frac{I_{mpp}}{I_{sc}} = \frac{I_{mpp}^*}{I_{sc}^*}$$
$$\frac{V_{mpp}}{V_{oc}} = \frac{V_{mpp}^*}{V_{oc}^*}$$

Procedimiento

- ▶ Calcular V_{oc} a la temperatura T_c :

$$V_{oc} = V_{oc}^* + \frac{dV_{oc}}{dT_c} \cdot (T_c - T_c^*)$$

- ▶ Calcular V_{mpp} a la temperatura T_c :

$$V_{mpp} = V_{oc} \cdot \frac{V_{mpp}^*}{V_{oc}^*}$$

- ▶ Calcular I_{sc} a la radiación G_{ef} .

$$I_{sc} = I_{sc}^* \cdot \frac{G_{ef}}{G^*}$$

- ▶ Calcular I_{mpp} a la radiación G_{ef}

$$I_{mpp} = I_{sc} \cdot \frac{I_{mpp}^*}{I_{sc}^*}$$

Ejercicio de Cálculo

De una célula de 100 cm^2 y $I_{sc}^* = 3 \text{ A}$, $I_{mpp}^* = 2.7 \text{ A}$,
 $V_{oc}^* = 0.6 \text{ V}$, $V_{mpp}^* = 0.48 \text{ V}$, calcular suponiendo factor de
forma constante:

▶ P_{mpp}^* , FF^* , η^*

▶ I_{mpp} , V_{mpp} cuando $T_c = 60^\circ\text{C}$ y $G = 800 \text{ W/m}^2$.

Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Curva IV y Puntos Característicos

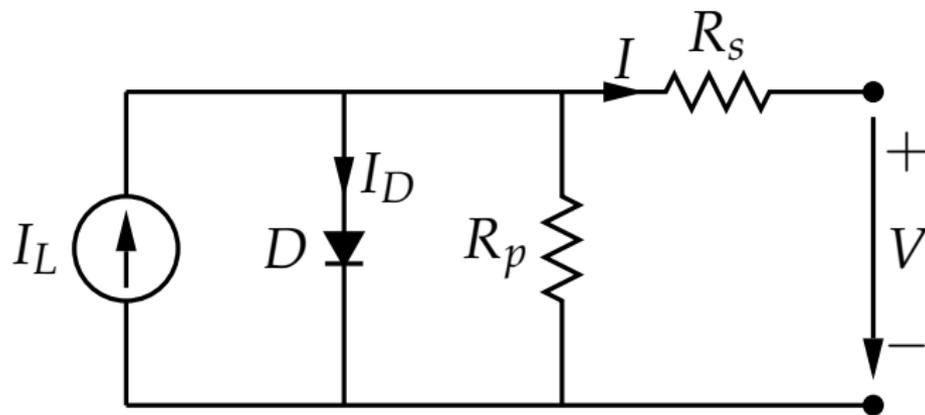
Influencia de Temperatura y Radiación

Cálculo del MPP

Circuito equivalente de la célula

Fabricación

Circuito equivalente



- ▶ Ecuación general

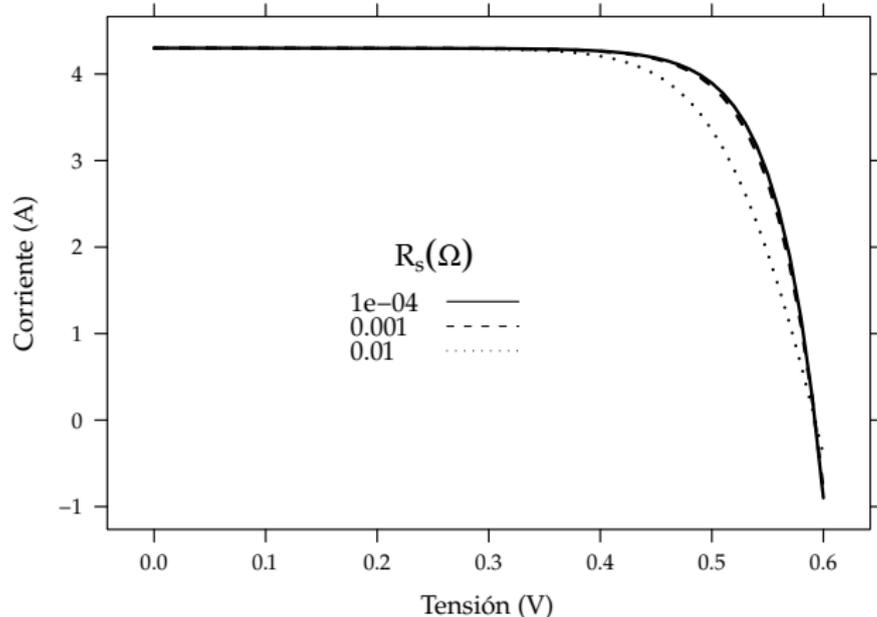
$$I = I_L - I_0 \cdot \left[\exp\left(\frac{V + I \cdot R_s}{m \cdot V_T}\right) - 1 \right] - \frac{V + I \cdot R_s}{R_p}$$

- ▶ Ecuación simplificada

$$I = I_{sc} \left[1 - \exp\left(\frac{V - V_{oc} + I \cdot R_s}{m \cdot V_t}\right) \right]$$

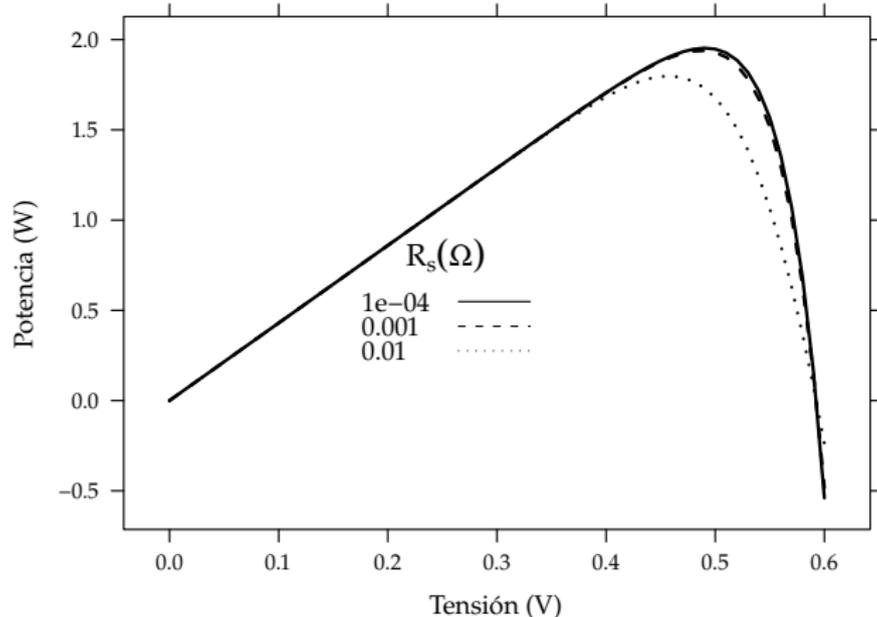
Resistencia Serie: Curva IV

- ▶ Resistencia de contactos metálicos con el semiconductor
- ▶ Resistencia de capas semiconductoras
- ▶ Resistencia de malla de metalización



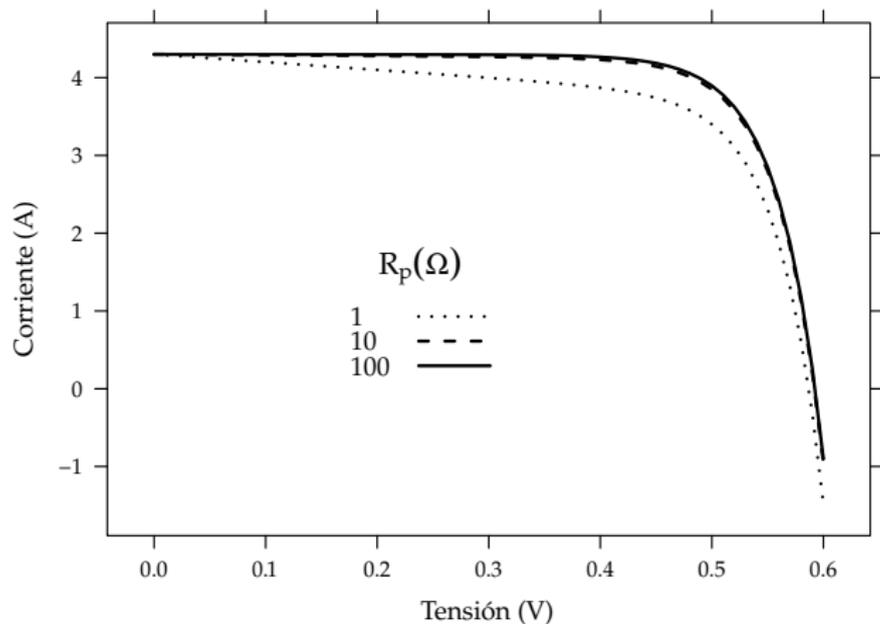
Resistencia Serie: Curva PV

- ▶ Resistencia de contactos metálicos con el semiconductor
- ▶ Resistencia de capas semiconductoras
- ▶ Resistencia de malla de metalización



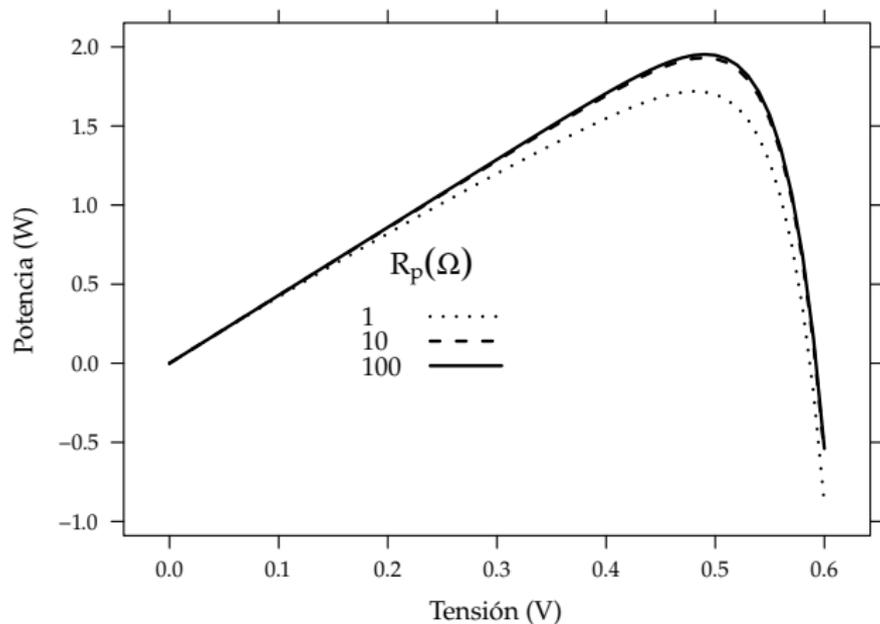
Resistencia paralelo: Curva IV

- ▶ Fugas de corriente en bordes de célula
- ▶ Cortocircuitos metálicos
- ▶ Caminos de difusión en fronteras de grano



Resistencia paralelo: Curva PV

- ▶ Fugas de corriente en bordes de célula
- ▶ Cortocircuitos metálicos
- ▶ Caminos de difusión en fronteras de grano



Teoría de Semiconductores

Unión P-N iluminada

Funcionamiento de una célula solar

Fabricación



<https://www.youtube.com/watch?v=BZKEkw0J9Nw>

https://www.youtube.com/watch?v=fZ1SC-vUe_I

Purificación de silicio

- ▶ El silicio puede extraerse de la cuarzita obteniendo Silicio de grado metalúrgico (98% pureza).
- ▶ Para la industria de la electrónica se necesita silicio de grado electrónico (nivel de impureza por debajo de 10^{-9} , 9 nueves).
- ▶ Para las células solares puede utilizarse silicio de grado solar (nivel de impureza algo mayor, 10^{-5} , 5 nueves).
- ▶ Al mezclar silicio con ácido clorhídrico se produce triclorosilano, que es destilado para eliminar impurezas.
- ▶ Al unir silano de cloro con hidrógeno se obtiene de vuelta silicio, válido para células policristalinas (varios cristales en cada célula)

Formación de obleas

- ▶ Para obtener mayor pureza se emplea el silicio monocristalino (un sólo cristal) obtenido mediante el proceso de Czochralski o similar (se utiliza una semilla de cristal para crecer silicio a muy alta temperatura).
- ▶ El lingote resultante debe ser cortado en obleas de $200 - 500 \mu m$.
- ▶ Las obleas son sometidas a limpieza para eliminar impurezas por el cortado.
- ▶ A continuación, son dopadas con Fósforo y Boro para crear la unión p-n.
- ▶ Se limpian los bordes para evitar la formación de cortocircuitos entre las zonas p y n.

- ▶ Se añaden los contactos posterior (alto recubrimiento) y anterior (optimización para obtener baja R_s y poco sombreado) empleando aleaciones de plata y aluminio.
- ▶ Para reducir las pérdidas por reflexión se añade una capa antireflectante con (p.ej) óxido de Titanio (color azulado).
- ▶ Si es posible, se textura la superficie (creación de mini pirámides).